Searching PAJ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-202593

(43)Date of publication of application: 19.07.2002

(51)Int.CI.

7/023 G03F CO8G 69/26 C08G 69/40 CO8G 69/42 G03F 7/037 H01L 21/027 H01L 21/312

(21)Application number: 2001-312165

(71)Applicant: SUMITOMO BAKELITE CO LTD

(22)Date of filing:

10.10.2001

(72)Inventor: HIRANO TAKASHI

OKAAKI SHIYUUSAKU

(30)Priority

Priority number : 2000333560

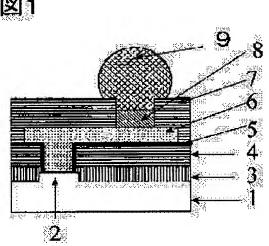
Priority date: 31.10.2000

Priority country: JP

(54) POSITIVE TYPE PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION, METHOD FOR PRODUCING THE SAME AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high sensitivity positive type photosensitive resin composition having superior mechanical characteristics, adhesiveness and water absorbing property as characteristics of a film after curing and capable of giving a pattern having high resolution and a high rate of a residual film. SOLUTION: The positive type photosensitive resin composition comprises 100 pts.wt. alkali-soluble resin, 1-100 pts.wt. photosensitive diazoquinone compound (B) and a filler (C) and the content F of the filler (C) represented by the equation F=(filler (C))/[(alkali-soluble resin)+(filler (C))] is 2-70 wt.%.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

Searching PAJ

application converted registration] [Date of final disposal for application] [Patent number] [Date of registration] [Number of appeal against examiner's decision of rejection] [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-202593 (P2002-202593A)

(43)公開日 平成14年7月19日(2002.7.19)

(51) Int.Cl.7		識別記号	F I	テーマコード(参考)		
G03F 7/023			G03F 7/023	2H025		
C 0 8 G	69/26		C 0 8 G 69/26	4 J 0 0 1		
	69/40		69/40	5F058		
	69/42		69/42			
G03F	7/037		G03F 7/037			
		審査請求	未請求 請求項の数14 OL	(全 20 頁) 最終頁に続く		
(21)出願番	}	特顧2001-312165(P2001-312165)	(71)出願人 000002141 住友ペークラ	ノト性マネル		
(22)出顧日		平成13年10月10日(2001.10.10)	「休み云仁 【品川2丁目5番8号			
(31) 優先権主張番号 (32) 優先日		特願2000-333560(P2000-333560) 平成12年10月31日(2000.10.31)	(72)発明者 平野 孝 東京都品川区 ベークライト	東品川2丁目5番8号 住友 株式会社内		
(33)優先檔主張国		日本 (JP)	(72)発明者 岡明 周作 東京都品川区東品川2丁目5番8号 ベークライト株式会社内			

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ポジ型感光性樹脂組成物、ポジ型感光性樹脂組成物の製造方法及び半導体装置

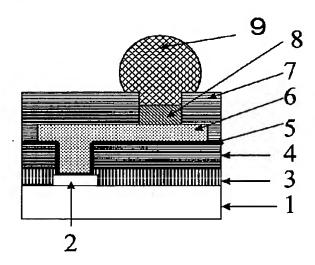
(57)【要約】

【課題】 高解像度で高残膜率のパターンを得ることができ、かつ硬化後の皮膜特性として優れた機械特性、接着性、吸水性を有する高感度のポジ型感光性樹脂を提供する。

【解決手段】 アルカリ可溶性樹脂100重量部と感光性ジアゾキノン化合物(B)1~100重量部とフィラー(C)からなり、下記式で表されるフィラー(C)の含有量Fが2~70重量%であるポジ型感光性樹脂組成物である。

F=フィラー (C) / (アルカリ可溶性樹脂+フィラー (C))

図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】 アルカリ可溶性樹脂100重量部と感光性ジアゾキノン化合物(B)1~100重量部とフィラー(C)からなり、下記式で表されるフィラー(C)の含有量Fが2~70重量%であることを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物。

*F=フィラー (C) / (アルカリ可溶性樹脂+フィラー (C))

【請求項2】 アルカリ可溶性樹脂が一般式(1)で示されるポリアミド(A)である請求項1記載のポジ型感光性樹脂組成物。

(1)

【化1】

式中X:4価の芳香族基 Y:2価の芳香族基

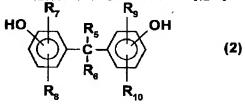
(R, R, 2:2価の有機基、R, R, 1価の有機基)

a,bはモル分率を示し、a+b=100モル% a=60.0~100.0モル% b=0~40.0モル% n=2~500

【請求項3】 請求項1又は2記載のポジ型感光性樹脂組成物が、アルカリ可溶性樹脂100重量部に対し一般式(2)で表わされるフェノール化合物(D)を1~3※

※0 重量部含むことを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物。

【化2】



(式中、 R_5 、 R_8 は水素原子またはアルキル基を表し、 R_7 、 R_8 、 R_9 、 R_{10} はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基、シクロアルキル基及びアルキル基の内から選ばれた一つを示す)

【請求項4】 一般式(1)のポリアミド(A)におけ ポジ型感光性樹脂組成物。 るXが、下記より選ばれてなる請求項2または3記載の 40 【化3】

$$\begin{array}{c|c}
 & CF_3 \\
 & CF_3 \\
 & CF_3
\end{array}$$

【請求項5】 一般式(1)のポリアミド(A)におけるYが、下記より選ばれてなる請求項2、3または4記*

*載のポジ型感光性樹脂組成物。



【請求項6】 フィラー(C)が、シリカ、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウムである請求項1、2、3、4 又は5記載のポジ型感光性樹脂組成物。

【請求項7】 フィラー(C)の平均粒径が、1nmから1000nmである請求項1、2、3、4又は5記載のポジ型感光性樹脂組成物。

【請求項8】 フィラー(C)を分散材を用いて溶液中に分散し、その後該溶液にアルカリ可溶性樹脂及び感光性ジアゾキノン化合物(B)を溶解することを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物の製造方法。

【請求項9】 アルカリ可溶性樹脂が一般式(1)で示されるポリアミド(A)である請求項8記載のポジ型感光性樹脂組成物の製造方法。

【請求項10】 請求項8又は9記載のポジ型感光性樹脂組成物が、アルカリ可溶性樹脂100重量部に対しー 40般式(2)で表わされるフェノール化合物(D)を1~30重量部含み、フィラー(C)を分散材を用いて溶液中に分散した後に、該フェノール化合物(D)を添加することを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物の製造方法。

【請求項11】 フィラー (C) が、シリカ、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウムである請求項8、9又は10記載のポジ型感光性樹脂組成物の製造方法。

【請求項12】 フィラー (C) の平均粒径が、1 n m 感光性を付与する技術が最近注目を集めてきており、例 から1000 n m である請求項8、9 又は10 記載のポ 50 えば感光性ポリイミド樹脂として、下記式 (3) 等があ

ジ型感光性樹脂組成物の製造方法。

【請求項13】 請求項1~7のいずれかに記載のポジ型感光性樹脂組成物を用いて製作された半導体装置。

【請求項14】半導体装置がフリップチップ実装用であ 0 る請求項13記載の半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高解像度で高残膜率のパターンを得ることができ、かつフィラーを配合することにより、良好な機械特性、接着特性、吸水特性を有し、アルカリ水溶液で現像可能な高感度のポジ型感光性樹脂組成物に関するものである。更に本ポジ型感光性樹脂組成物を用いて製作された半導体装置に関するものである。

0 [0002]

【従来の技術】従来、半導体素子の表面保護膜、層間絶縁膜には耐熱性が優れ、又卓越した電気特性、機械的特性等を有するポリイミド樹脂が用いられているが、近年半導体素子の高集積化、大型化、封止樹脂パッケージの薄型化、小型化、半田リフローによる表面実装への移行等により耐熱サイクル性、耐熱ショック性等の著しい向上の要求があり、更に高性能のポリイミド樹脂が必要とされるようになってきた。一方、ポリイミド樹脂自身に感光性を付与する技術が最近注目を集めてきており、例えば感光性ポリイミド樹脂として、下記式(3)等があ

る。

[0003]

5

簡略化でき、工程短縮の効果はあるが、現像の際にN-メチルー2ーピロリドン等の溶剤が必要となるため、安 全、取扱いにおいて問題がある。そこで最近では、アル カリ水溶液で現像ができるポジ型の感光性樹脂が開発さ れている。例えば、特公平1-46862号公報におい てはポリベンゾオキサゾール前駆体とジアゾキノン化合 物より構成されるポジ型感光性樹脂が開示されている。 これは高い耐熱性、優れた電気特性、微細加工性を有 し、ウェハーコート用のみならず層間絶縁用樹脂として の可能性も有している。このポジ型の感光性樹脂の現像 メカニズムは、未露光部のジアゾキノン化合物がアルカ リ性水溶液に不溶であり、露光することによりジアゾキ ノン化合物が化学変化を起こし、アルカリ性水溶液に可 溶となる。この露光部と未露光部での溶解性の差を利用 し、未露光部のみの途膜パターンの作成が可能となる。 【0005】また、近年特に感光性樹脂の髙感度化が強 く望まれている。低感度であると、ウェハー1枚あたり の露光時間が長くなり、スループットが低下するからで ある。そこで感光性樹脂の高感度化を目的として、例え ばベース樹脂のポリベンゾオキサゾール樹脂の分子量を 小さくしただけでは、非露光部の現像時における膜減り が大きくなり所望の膜厚を得ることが不可能となるだけ でなく、そのパターン形状も悪くなるという問題が生じ る。また熱により脱水閉環させた硬化膜の機械的特性も 著しく低下するという不具合も起こる。この様なことか ら、上記特性を満足しながら高感度である感光性樹脂の 開発が望まれていた。

【0004】これを用いるとパターン作成工程の一部が

【0006】さらには、近年特にウエハの大型化が進み、300mmウエハが使用されるようになってきた。

大きなウエハではSiウエハと感光性樹脂との線膨張係数が異なるために、ウエハに反りが生じ、ウエハを薄く削る裏面研削の工程でウエハが割れる等の問題が起こっている。したがって感光性樹脂の線膨張係数をシリコンウエハに近づけた低応力の感光性樹脂の開発が望まれていた。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、アルカリ水 溶液で現像が可能で、高解像度で高残膜率のパターンを 得ることができ、かつ硬化後の皮膜特性として優れた機 械特性、接着性、吸水性を有する高感度のポジ型感光性 樹脂を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】アルカリ可溶性樹脂100重量部と感光性ジアゾキノン化合物(B)1~100重量部とフィラー(C)からなり、下記式で表されるフィラー(C)の含有量Fが2~70重量%であるポジ型感光性樹脂組成物である。

F=フィラー(C)/(アルカリ可溶性樹脂+フィラー(C))

更に好ましい形態としては、アルカリ可溶性樹脂が一般式 (1) で示されるポリアミド (A) であり、このポジ型感光性樹脂組成物が、アルカリ可溶性樹脂 100 重量部に対し一般式 (2) で表わされるフェノール化合物 (D) を $1\sim30$ 重量部含み、フィラー (C) が、シリカ、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウムであり、フィラー (C) の粒径が、1 nmから 100 nmであるポ

[0009]

40 ジ型感光性樹脂組成物である。

【化6】

(1)

7

式中X:4価の芳香族基 Y:2価の芳香族基

(R₄、R₂: 2価の有機基、R₃、R₄: 1価の有機基)

a,bはモル分率を示し、a+b=100モル% a=60.0~100.0モル% b=0~40.0モル% n=2~500

【化7】

$$\begin{array}{c|c} R_7 & R_5 & OH \\ \hline R_8 & R_{10} & \end{array}$$

(式中、Rg、Rgは水素原子またはアルキル基を表し、 R7、R8、R8、R10はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、 水酸基、アルコキシ基、シクロアルキル基及びアルキル基の内 から選ばれた一つを示す)

【0010】また、フィラー (C) を分散材を用いて溶 液中に分散し、その後該溶液にアルカリ可溶性樹脂及び 感光性ジアゾキノン化合物(B)を溶解するポジ型感光 性樹脂組成物の製造方法である。また、上記のポジ型感 光性樹脂組成物を用いて製作された半導体装置であり、 好ましくは、半導体装置がフリップチップ実装用に用い られる半導体装置である。

[0011]

【発明の実施の形態】アルカリ可溶性樹脂としては、例 えば、ヒドロキシポリアミド、ポリアミド酸、フェノー 40 【化8】 ルノボラック等であるが、耐熱性と感光性を両立するた

めに、ヒドロキシポリアミドが好ましく、特に一般式 (1) で示されるものが好ましい。一般式(1)で示さ れるポリアミド (A) は、Xの構造を有するビスアミノ フェノールとYの構造を有するジカルボン酸からなり、 このポリアミド(A)を約300~400℃で加熱する と閉環し、ポリベンゾオキサゾールという耐熱性樹脂に 変化する。本発明の一般式(1)で示されるポリアミド (A) のXは、例えば、

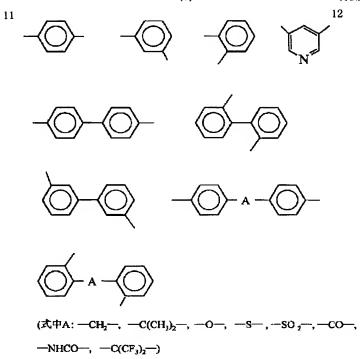
[0012]

(式中A: --CH₂--, --C(CH₃)₂--, --O--, --S--, --SO ₂--, --CO--, --NHCO--, --C(CF₃)₂--)

【0013】等であるがこれらに限定されるものではな *【0014】

【0015】より選ばれるものである。又一般式(1)のYは、例えば、

【0016】 【化10】



【0017】等であるがこれらに限定されるものではな * 【0018】 い。これらの中で特に高感度のものとしては * 【化11】

【0019】より選ばれるものである。更に、一般式【0020】(1) のZは、例えば【化12】

【0021】等であるがこれらに限定されるものではな 20 い。一般式 (1) の Z は、例えば、シリコンウェハーの ような基板に対して、特に密着性が必要な場合に用いる が、その使用割合 b については最大 4 0 モル%まで使用 することができる。 4 0 モル%を越えると樹脂の溶解性 が極めて低下し、スカムが発生し、パターン加工ができない。なお、これら X、Y、Zの使用にあたっては、それぞれ 1 種類であっても 2 種類以上の混合物であっても 構わない。

【0022】本発明で用いる感光性ジアゾキノン化合物(B)は、1,2ーベンゾキノンジアジドあるいは1,2ーナフトキノンジアジド構造を有する化合物であり、米国特許公報第2,772,972号、第2,797,213号、第3,669,658号により公知の物質である。例えば、下記のものが挙げられる。

【0023】 【化13】

$$QO \longrightarrow CH_3 \longrightarrow Q$$

$$\begin{array}{ccc} CH_3 & CH_3 \\ | & | \\ Q\text{- NH- (CH}_2)_{\overline{1}}\text{- Si} & -O & -Si & -(CH_2)_3 & - \text{ NH- Q} \\ | & | & | \\ CH_3 & CH_3 \end{array}$$

[0024]

(式中Qは水素原子又は

* *【化14】

$$\begin{array}{c|c} O & N_2 & O & N_2 \\ \hline O & N_2 & O & N_2 \\ SO_2 & SO_2 & SO_2 & O \end{array}$$

【0025】これらの中で特に高残膜率の点から好ましいものとしては下記のものがある。

【0026】 【化15】

(式中
$$Q$$
は水素原子 Q は O N_2 N_2 から選ばれ SO_2

各化合物においてそれぞれ少なくとも1個は、

である。)

【0027】感光性ジアジドキノン化合物(B)のアルカリ可溶性樹脂への配合量は、アルカリ可溶性樹脂10.0重量部に対し、1~100重量部で、配合量が1重量部未満であると樹脂のパターニング性が不良であり、逆に100重量部を越えるとフィルムの引張り伸び率が著しく低下する。

【0028】本発明のポジ型感光性樹脂組成物には、必 30 要により感光特性を高めるためにジヒドロキシピリジン誘導体を加えることができる。ジヒドロキシピリジン誘導体としては、例えば2,6-ジメチル-3,5-ジアセチル-4-(2'-ニトロフェニル)-1,4-ジヒドロキシピリジン、4-(2'-ニトロフェニル)-2,6-ジメチル-3,5-ジカルボエトキシー1,4-ジヒドロキシピリジン、4-(2',4'-ジニトロフェニル)-2,6-ジメチル-3,5-カルボメトキシー1,4-ジヒドロキシピリジン等を挙げることができる。 40

【0029】本発明で用いるフィラー(C)とは、有機フィラー、無機フィラー、顔料である。これらは単独で用いても良く、また2種以上混合して用いても良い。有機フィラーとしては、例えば、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、尿素樹脂、アクリル樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、フッ素樹脂である。無機フィラーとしては、例えば、アルミナ、シリカ、マグネシア、フェライト、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウムなどの金属酸化微粒子、あるいはタルク、マイカ、カオリン、ゼオライトなどの珪酸塩

類、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、フラーレンなどの 微粒子を用いる。上記フィラーは1種または2種以上を 混合して使用する。特に酸化アルミニウム、酸化ジルコ ニウムは混合後もチキソ性がでず、スピンナにより均一 塗布できるために好ましい。また、硬化物の線膨張係 数、コストの点などよりシリカも好ましい。

0 【0030】上記フィラー(C)は、好ましくは、平均 粒径が $1\sim1000$ nm以下の微粒子であり、さらに好 ましくは $1\sim100$ nm以下の微粒子である。平均粒径 が1000nmを越えると解像度、感度の低下をまねき 好ましく、1nm未満であれば混合が難しくなる。フィ ラー(C)の含有量Fは次の式で表される。

F=フィラー (C) / (アルカリ可溶性樹脂+フィラー (C))

フィラーの含有量F (重量基準) は、2~70重量%であり、好ましくは2~50重量%である。2重量%未 3 満では添加効果がほとんどなく、70重量%を越えると 現像時間が極端に長くなったり、硬化後の被膜形成ができなくなる。

【0031】本発明に使用される顔料としては、例えば、酸化チタン等の着色顔料である。

【0032】本発明のポジ型感光性樹脂組成物においては、更に一般式(2)で表わされるフェノール化合物

(D) を含有させることが好ましい。

[0033]

【化16】

$$\begin{array}{c} R_{7} \\ R_{5} \\ R_{8} \\ R_{10} \end{array} OH$$
 (2)

(式中、 R_6 、 R_6 は水素原子またはアルキル基を表し、 R_7 、 R_8 、 R_9 、 R_{10} はそれぞれ水素原子、 Λ いり原子、水酸基、Tルコキシ基、シクロアルキル基及びアルキル基の内から選ばれた一つを示す)

【0034】フェノール化合物をポジ型レジスト組成物に添加する技術としては、例えば、特開平3-200251号公報、特開平3-200254号公報、特開平4-1651号報、特開平4-1651号公報、特開平4-11260号公報、特開平4-12356号公報、特開平4-12357号公報に示されている。しかし、これらに示されているようなフェノール化合物は、本発明におけるポリアミドをベース樹脂とした 20ポジ型感光性樹脂組成物に用いても感度向上の効果は小さい。しかし、本発明における一般式(2)で表わされるフェノール化合物を用いた場合、露光部における溶解

19

速度が増し、感度が向上する。又アルカリ可溶性樹脂の分子量を小さくし感度を上げた場合に見られるような未露光部の膜減りも非常に小さい。又本発明においては、一般式(2)で表わされるフェノール化合物を添加することによる新たな特性として、封止樹脂との密着性が向上したポジ型感光性樹脂組成物が得られるということを見い出した。

20

【0035】一般式(2)に示される化合物としては下記のもの等を挙げることができるがこれらに限定されない。

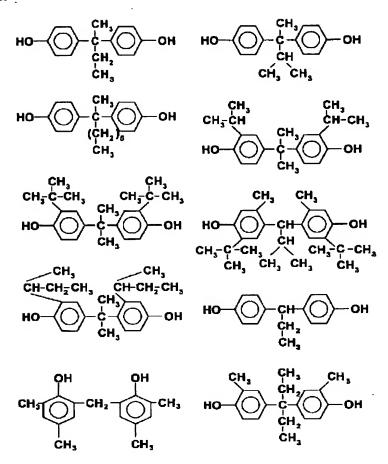
[0036]

【化17】

2

[0037]

【化18】



[0038]

【0039】これらの中で特に、感度及び残膜率の点で

好ましいものとしては、

(CH₂)₈ ĊH₃

*【化20】

ĊH,

である。

【0040】一般式(2)で表わされるフェノール化合 物 (D) は単独で用いても良いが、前述の公報に示され 50 ール化合物中に50重量%以上含まれるものである。全

ているフェノール化合物と併用することもでき、その場 合一般式(2)で表されるフェノール化合物は全フェノ

出が起こり実用性に欠ける。

フェノール化合物の添加量としては、アルカリ可溶性樹 脂100重量部に対して1~50重量部が好ましい。一 般式(2)で表わされるフェノール化合物(D)はアル カリ可溶性樹脂100重量部に対し1~30重量部であ ることが好ましい。添加量が1重量部未満だと感度向上 の効果が得られず、又添加量が30重量部を越えると残 膜率の低下が大きくなったり、又冷凍保存中において析

【0041】本発明におけるポジ型感光性樹脂組成物に の添加剤を添加することができる。本発明においてはこ れらの成分を溶剤に溶解し、ワニス状にして使用する。 溶剤としては、例えば、N-メチル-2-ピロリドン、 ν ーブチロラクトン、N. Nージメチルアセトアミド、 ジメチルスルホキシド、ジエチレングリコールジメチル エーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジ エチレングリコールジブチルエーテル、プロピレングリ コールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモ ノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエ ーテルアセテート、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸ブチ 20 ル、メチルー1、3ーブチレングリコールアセテート、 1, 3-ブチレングリコール-3-モノメチルエーテ ル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、メチル-3 ーメトキシプロピオネート等を単独でも混合して用いて もよい。

【0042】本発明におけるポジ型感光性樹脂組成物の 製造方法として、前記のフィラー、アルカリ可溶性樹 脂、感光剤とを有機溶媒等に混合する際は、フィラーが 樹脂組成物中に均一に分散することが好ましい。その 為、フィラーの二次凝集を防ぐために、予めフィラーを 分散材を用いて溶媒中に均一分散しておき、その後アル カリ可溶性樹脂、感光剤等を溶解していくと、均一なワ ニスが得られる。分散材としては、例えば、陰イオン活 性剤、陽イオン活性剤、非イオン活性剤、両性イオン活 性材などが挙げられるが、この中で陽イオン活性剤、非 イオン活性剤が好ましい。この中でリン酸エステル系の 活性剤が好ましい。分散は公知の方法で行うことがで き、例えば、ボールミル、ロールミル、ダイヤモンドミ ル等剪断力の強い分散装置を用いて、分散混合の良好な 感光性樹脂組成物を得ることができる。更に、分散混合 を良好に行うため、湿潤剤、分散材、シランカップリン グ剤、チタンカップリング剤、消泡剤等を添加するか、 あらかじめフィラーに疎水処理を実施することも可能で ある。

【0043】本発明のポジ型感光性樹脂組成物の使用方 法は、まず該組成物を適当な支持体、例えば、シリコン ウェハー、セラミック、アルミ基板等に塗布する。塗布 方法としては、スピンナーを用いた回転塗布、スプレー コーターを用いた噴霧塗布、浸漬、印刷、ロールコーテ

て塗膜を乾燥後、所望のパターン形状に化学線を照射す る。化学線としては、X線、電子線、紫外線、可視光線 等が使用できるが、200~500 nmの波長のものが 好ましい。次に照射部を現像液で溶解除去することによ りレリーフパターンを得る。

28

【0044】現像液としては、例えば、水酸化ナトリウ ム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウ ム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アル カリ類、エチルアミン、n-プロピルアミン等の第1ア は、必要によりレベリング剤、シランカップリング剤等 10 ミン類、ジエチルアミン、ジーn-プロピルアミン等の 第2アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミ ン等の第3アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリ エタノールアミン等のアルコールアミン類、テトラメチ ルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウ・ ムヒドロキシド等の第4級アンモニウム塩等のアルカリ 類の水溶液、及びこれにメタノール、エタノールのごと きアルコール類等の水溶性有機溶媒や界面活性剤を適当 量添加した水溶液を好適に使用することができる。現像 方法としては、スプレー、パドル、浸漬、超音波等の方 式が可能である。次に、現像によって形成したレリーフ パターンをリンスする。リンス液としては、蒸留水を使 用する。次に加熱処理を行い、オキサゾール環を形成 し、耐熱性に富む最終パターンを得る。

> 【0045】本発明によるポジ型感光性樹脂組成物を半 導体装置に用いると高信頼性の半導体装置を得ることが 出来る。特にフリップチップ実装用の半導体装置に用い ると更に大幅なコストを削減することが出来る。本発明 によるポジ型感光性樹脂組成物は、半導体用途のみなら ず、多層回路の層間絶縁やフレキシブル銅張板のカバー コート、ソルダーレジスト膜等としても有用である。こ れらの製造方法は本発明によるポジ型感光性樹脂組成物 を用いる以外は従来の公知の方法を用いることができ

【0046】本発明のポジ型感光性樹脂組成物を用いた 半導体装置の一例を図1を用いて説明する。図1は、本 発明のバンプを有する半導体措置のパッド部分の拡大断 面図である。図1に示すように、シリコンウエハ1には 入出力用のA1パッド2上にパッシベーション膜3が形 成され、そのパッシベーション膜3にビアホールが形成 されている。更に、この上にポリベンゾオキサゾール樹 脂膜(バッファーコート膜4)を形成する。この塗膜4 をg線ステッパー露光機を用いて照射した後、現像液に 浸漬することによって露光部を溶解除去し、純水で30 秒間リンスしてパターンを得る。次にクリーンオーブン を用いて、窒素雰囲気下で30分/150℃、30分/ 250℃、30分/350℃の順で硬化を行う。次にリ アクティブイオンエッチング (RIE) を用いてパッシ ベーション膜3をエッチングする。その上に、スパッタ 法で金属(Cr、Ti等)膜5を形成し、A1パッド2 ィング等がある。次に、60~120℃でプリベークし 50 と接続されるようにする。その金属膜5はハンダバンプ

29

9の周辺をエッチングして取り除かれ、各パッド間を絶 縁する。

【0047】次に、配線6をメッキ法で成膜する。次 に、ポジ型感光性樹脂を塗布し、フォトリソ工程を経て パターン(絶縁膜7)を形成する。ついで、バリアメタ ル8、ハンダを順次メッキする。ついで、フラックスを **塗布し加熱してハンダを溶解する。次に、フラックスを** 洗浄し、ハンダバンプ9を形成して図1の構成のものを 得る。このものはスクライブラインに沿ってダイシング してチップ毎に切り分けられる。

[0048]

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明す

ジフェニルエーテルー4、4'ージカルボン酸1モルと

《実施例1》

*ポリアミドの合成

1-ヒドロキシベンゾトリアゾール2モルとを反応させ て得られたジカルボン酸誘導体492.5重量部(1モ ル) とヘキサフルオロー2, 2-ビス (3-アミノー4 ーヒドロキシフェニル) プロパン347.9重量部 (0.95モル)とを温度計、攪拌機、原料投入口、乾 燥窒素ガス導入管を備えた4つ口のセパラブルフラスコ に入れ、N-メチル-2-ピロリドン3000重量部を 加えて溶解させた。その後オイルバスを用いて75℃に て12時間反応させた。次に、反応混合物をろ過した 後、反応混合物を水/メタノール=3/1の溶液に投 入、沈殿物を濾集し水で充分洗浄した後、真空下で乾燥 し、目的のポリアミド (A-1) を得た。

【0049】*ポジ型感光性樹脂組成物の作製 シリカ (C-1:平均粒径100nm, 比表面積40m 30 $^2/$ g)10重量部、非イオン性アニオン活性剤(フォ スファノールRE-610 (東邦化学工業(株)製)) 1 重量部をダイヤモンドミルを用いてγ-ブチロラクト ン250 重量部に分散した後、合成したポリアミド (A -1) 100重量部、下記式の構造を有するジアゾキノ ン (B-1) 25 重量部を加え溶解した後、1 μ mのフ ッ素樹脂製フィルターで濾過し感光性樹脂組成物を得

【0050】*特性評価

このポジ型感光性樹脂組成物をシリコンウェハー上にス 40 ピンコーターを用いて塗布した後、ホットプレートにて 120℃で4分乾燥し、膜厚約7μmの塗膜を得た。こ の塗膜にg線ステッパー露光機NSR-1505G3A (ニコン (株) 製) によりレチクルを通して50mJ/ cm^2 から $20mJ/cm^2$ づつ増やして 540mJ/c m^2 まで露光を行った。次に2.38%のテトラメチル アンモニウムヒドロキシド水溶液に40秒浸漬すること によって露光部を溶解除去した後、純水で30秒間リン スした。その結果、露光量290m J/c m²の照射し た部分よりパターンが成形されており、パターン底部に 50 解した後、下記式の構造を有するジアゾキノン (B-

スカムが無いことが確認できた(感度は290mJ/c m²)。この時の残膜率(現像後の膜厚/現像前の膜 厚)は92.0%と非常に高い値を示した。

30

【0051】又、別にポジ型感光性樹脂組成物を同様に 2枚のシリコンウェハー上に塗布し、プリベークした 後、オーブン中30分/150℃、30分/250℃、 30分/350℃の順で加熱、樹脂を硬化させた。この ときの硬化収縮率は15%であった。その後2%フッ化 水素水溶液に浸漬することによりシリコンウェハーから 10 剥離した硬化フィルムを、水で十分洗浄し乾燥を行った 後に熱機械分析(TMA)で線膨張係数を測定したとこ ろ3. 7 x 1 0 ⁻⁵ 1 / ℃という低い値を得た。またこ の硬化フィルムの24時間純水中に浸漬し吸水率を測定 したところ0.2%であった。

【0052】《実施例2》実施例1におけるポリアミド の合成において、2、2-ビス(3-アミノ-4-ヒド ロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン348 重量部 (0.95モル)と1,3ービス(3ーアミノプロピ (1, 1, 3, 3- テトラメチルジシロキサン1)20 2. 4 重量部 (0.05モル)を用い、一般式 (1)で 示され、Xが下記式X-1、Yが下記式Y-1で、Zが Z-1で、a=95、b=5からなるポリアミドを合成 した。その他は実施例1と同様の評価を行った。

【0053】《実施例3》実施例1におけるジアゾキノ ン化合物を、下記式B-2に替えて評価を行った。

《実施例4》実施例1におけるポジ型感光性樹脂組成物 にフェノール化合物 (P-1) 10 重量部添加して評価 を行った。

【0054】《実施例5》実施例4におけるフェノール 化合物 (P-1) の添加量を5重量部にして評価を行っ

《実施例 6》実施例 1 におけるシリカ (C-1) を酸化 ジルコン(C-2:平均粒径10nm、比表面積50m 2/g) にして評価を行った。

【0055】《実施例7》実施例1におけるシリカを3 0 重量部にして評価を行った。

【0056】《比較例1》実施例1において、シリカを 添加しないで評価を行った。

《比較例2》実施例1においてのシリカの添加量を40 0 重量部に増やして評価を行った。

《比較例3》実施例1においてのシリカをシリカの添加 量を0.5重量部にして評価を行った。

【0057】《比較例4》実施例1においてフォスファ ノールRE-610を添加せずにポジ型感光性樹脂組成 物の調整を行った。シリカフィラーの二次凝集が起こり 1 μ m のフッ素樹脂製フィルターで濾過できなかった為 良好な製品が得られなかった。評価は実施しなかった。

【0058】《比較例5》yーブチロラクトン250重 量部に合成したポリアミド (A-1) 100重量部を溶

32

31

1) 25 重量部を加え溶解した。その後固体のシリカを加え撹拌したが、シリカが均一に分散できず、 $1 \mu m$ のフッ素樹脂製フィルターで濾過できなかった為良好な製品が得られなかった。評価は実施しなかった。

*【0061】 【化22】

【0059】実施例1~7、比較例1~5に用いた樹脂成分の内容を下記に示す。

[0060]

【化21】

$$\begin{array}{c|c} CF_3 & & & \\ \hline \\ CCF_3 & & & \\ \hline \end{array}$$

20

[0062]

【化23】

³³**B-2:**

【0063】 【化24】

*【0064】実施例1~7、比較例1~3に用いた樹脂

* 組成物の配合を表1に示す。

【表1】

		数1	11	_							
1		ポリアミド		感光材		フィラー		フェノール化合物			
Ш		アミン	酸	シリコン ジアミン	添加量 重量部	構造	添加量重量部	構造	添加量 重量部	構造	添加量 重量部
実	1	_X-1	Y-1		100	B-1	25	C-1	10		
I	2	X-1	Y-1	Z-1	100	B-1	25	C-1	10	_	
施	3	X-1	_Y-1	_	100	B-2	25	C-1	10	-	_
I I	4	X-1	Y-1	_	100	8-1	25	C-1	10	P-1	10
(P)	5	X-1	Y-1	_	100	B-1	25	C-1	10	P-1	5
1 1	6	X-1_	Y-1		100	B-1	25	C-2	10	_	
ш	7	X-1	Y-1	-	100	B-1	25	C-1	30	_	
比	1	X-1	Y-1	_	100	B-1	25		_	_	
較	2	X-1	·Y-1		100	B-1	25	C-1	400		
9	3	X-1	Y-1		100	B-1	25	C-1	0.5	_	

【0065】実施例1~7、比較例1~3の評価結果を 40 【表2】 まとめて表2に示す。 35

36

		表2				
		感度	残膜率	硬化収縮率	線膨張係数	吸水率
		mJ/cm²	%	96	1/℃	96
実	1	290	92	15	3.7x10 ⁻⁵	0.2
	2	300	90	15	4.0x10 ⁻⁶	0.2
推	3	250	93	14	3.7x10 ⁻⁵	0.2
	4	230	92	16	3.9x10 ⁻⁵	0.3
例	5	240	91	16	3.9x10 ⁻⁵	0.3
	6	280	93	17	3.7x10 ⁻⁵	0.2
	7	310	90	12	2.5x10 ⁻⁵	0.3
比	1	350	86	20	5.5x10 ^{−5}	0.4
較	2	400	94	3	フィルムにならず	1
例	3	450	87	20	5.5×10 ⁻⁵	0.4

[0066]

【発明の効果】本発明によって、高解像度で高残膜率のパターンを形成することができ、かつ硬化後の皮膜特性として優れた機械特性、接着性、吸水性を有する高感度のポジ型感光性樹脂組成物を提供することが可能になった。また、本発明のポジ型感光性樹脂組成物を用いると高信頼性の半導体装置を得ることが出来る。

【図面の簡単な説明】

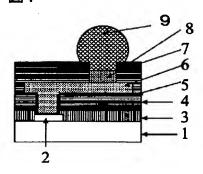
【図1】本発明の半導体装置の一例の断面模式図である。

【符号の説明】

- 1. シリコンウェハ
- 2. A1パッド
- 3. パッシベーション膜
- 4. バッファコート膜
- 5. 金属 (Cr、Ti等) 膜
- 6. 配線 (A1、Cu等)
- 7. 絶縁膜
- 20 8. バリアメタル
 - 9. ハンダバンプ

【図1】

図1



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷

識別記号

FΙ

HO1L 21/312

テーマコード(参考)

H 0 1 L 21/027

21/312

21/312

502R

Fターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AA04 AA13 AA14 AB16 AC01 AD03 BE01 CB15

CC06 CC08 FA17

4J001 DA01 DB01 DB04 DC05 DC08

DC14 DD01 DD04 DD05 EB25

EB28 EB35 EB36 EB37 EB56

EB57 EB58 EB59 EB60 EC23

EC28 EC33 EC36 EC38 EC44

EC66 EC67 EC68 EC69 EC70

EE08E EE14E EE18E EE35E

EE72E FA01 FB03 FC03

JA07 JB34 JC08

5F058 AA10 AC03 AC07 AF04 AG01

AH02 AH03